

СООБЩЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДУБНА

В 64

P17-88-896

В.И.Возяков*, Г.М. Гавриленко

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ
АДСОРБИРОВАННЫХ ПЛЕНОК

*Чувашский государственный университет
им. И.Н.Ульянова, г. Чебоксары

1988

Настоящая работа посвящена применению метода функционального интегрирования для исследования поведения электронной подсистемы адсорбционных пленок на подложке с регулярной структурой. Для описания электронных свойств хемосорбционных покрытий в последнее время начали использоваться составные модельные гамильтонианы типа Андерсона - Изинга. Вывод таких гамильтонианов из первых принципов приведен в работе^{1/}. Излагаемый ниже подход основан на схеме функционального интегрирования, примененной в работах^{2/} для исследования квантовой кристаллизации ферми-системы.

Рассмотрим гамильтониан (постоянная Планка $\hbar = 1$)^{1/}

$$H = \sum_{\vec{R}, \sigma} (\frac{\vec{k}^2}{2m} - \mu) n_{\vec{R}, \sigma} + \sum_{\alpha, \sigma} N_{\alpha} \left\{ (E - \mu) n_{\alpha, \sigma} + \frac{U}{2} n_{\alpha, \sigma} n_{\sigma, \alpha} + \sqrt{\frac{2}{V}} \sum_{\vec{R}} (V_{\alpha, \vec{R}} a_{\alpha, \sigma}^{\dagger} a_{\vec{R}, \sigma} + \text{с.с.}) \right\} \quad (I)$$

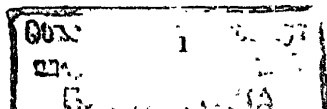
где μ - химический потенциал электронной подсистемы адсорбента (кристалла со свободной поверхностью), который определяется из условия сохранения числа электронов в системе;

$n_{\vec{R}, \sigma} = a_{\vec{R}, \sigma}^{\dagger} a_{\vec{R}, \sigma}$, $n_{\alpha, \sigma} = a_{\alpha, \sigma}^{\dagger} a_{\alpha, \sigma}$; $a_{\vec{R}, \sigma}^{\dagger}$, $a_{\vec{R}, \sigma}$, $a_{\alpha, \sigma}^{\dagger}$, $a_{\alpha, \sigma}$ - ферми-операторы рождения и уничтожения электронов в состояниях (\vec{R}, σ) и (α, σ) соответственно; \vec{R} - квазиимпульс электрона в подложке металла, отвечающий континуум-состояниям^{3/}; $\sigma = \pm 1$ - спиновый индекс; α нумеруем все возможные центры адсорбции; $N_{\alpha} = 0$ или $N_{\alpha} = 1$, что характеризует числа заполнения ионами примеси этих центров.

E - ионизационный потенциал примеси, находящейся на узле α ;

$V_{\alpha, \vec{R}}$ - матричные элементы перехода валентных электронов адатомов (адсорбированных атомов) в зону кристаллической подложки. U - энергия отталкивания валентных электронов примеси α -го узла,

$E - \mu = \epsilon < 0$, V_{α} - объем подложки, занимающей пролупространство $\vec{r} > 0$. Гамильтониан вида (I) описывает систему из адсорбента и адсорбата, состоящего из ионных остовов водородоподобных адатомов и их валентных электронов.



Далее положим $N_\alpha = 1$ для заданного регулярного распределения примесей на подложке, т.е. ограничимся рассмотрением так называемой периодической модели Андерсона. В гамильтониане (1) введем "новый" набор операторов вместо $a_{\alpha,6}^+, a_{\alpha,6}$:

$$a_{\alpha,6}^+ = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{q}} e^{i\vec{R}_\alpha \vec{q}} a_{\vec{q},6}^+ ; \quad a_{\alpha,6} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{q}} e^{-i\vec{R}_\alpha \vec{q}} a_{\vec{q},6} , \quad (2)$$

где \vec{R}_α - радиус-вектор узла α ; \vec{q} - двумерный импульс из первой зоны Бриллюэна электронов адсорбционной пленки, лежащей в плоскости подложки, а $2N$ - число состояний в этой зоне. Тогда получим

$$H = \sum_{\vec{k},6} \varepsilon_{\vec{k}} a_{\vec{k},6}^+ a_{\vec{k},6} + \sum_{\vec{q},6} \varepsilon a_{\vec{q},6}^+ a_{\vec{q},6} + \frac{\kappa}{2N} \sum_{\vec{q},6} \rho_{\vec{q},6} \times \quad (3)$$

$$\rho_{\vec{q},6} + \sqrt{\frac{2}{V}} \sum_{\vec{q},6, \vec{k}} (V_{\vec{q},\vec{k}} a_{\vec{q},6}^+ a_{\vec{k},6} + \text{с.с.}) ,$$

где

$$\varepsilon_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \mu ; \quad \rho_{\vec{q},6} = \sum_{\vec{q}',6} a_{\vec{q}',6}^+ a_{\vec{q}+\vec{q}',6} , \quad (4)$$

$$V_{\vec{q},\vec{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\alpha} V_{\alpha,\vec{k}} e^{i\vec{R}_\alpha \vec{q}} .$$

Ферми-системе с гамильтонианом (3) сопоставим функционал действия

$$S = \sum_{\vec{k},\omega,6} (i\omega - \varepsilon_{\vec{k}}) a_{\vec{k},6}^+(\omega) a_{\vec{k},6}(\omega) + \sum_{\vec{q},\omega,6} (i\omega - \varepsilon) a_{\vec{q},6}^+(\omega) a_{\vec{q},6}(\omega) - \frac{\kappa}{2\beta N} \sum_{\vec{p},6} \rho_{\vec{p},6} \rho_{-\vec{p},6} - \sqrt{\frac{2}{V}} \sum_{\vec{q},6, \vec{k}} (V_{\vec{q},\vec{k}} a_{\vec{q},6}^+(\omega) a_{\vec{k},6}(\omega) + \text{с.с.}) \quad (5)$$

где $\omega = (2n+1)\pi/\beta$ - ферми-частота, $\beta^{-1} = T$ - температура в энергетических единицах, κ - целое число.

$$\rho_{\vec{p},6} = \sum_{\vec{q},\omega, \omega'} a_{\vec{q},6}^+(\omega) a_{\vec{q}+\vec{p},6}(\omega') , \quad (6)$$

где $\omega_1, \omega_1 + \omega'$ - ферми-частоты, $\vec{p} = (\vec{q}, \omega')$,

Дальнейшая наша задача заключается в получении функционала эффективного действия, определяющего многие свойства модельной системы (3).

2. ФУНКЦИОНАЛ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ АДСОРБЦИОННОЙ ПЛЕНКИ

Рассмотрим функциональный интеграл по грассмановым переменным

$$\int \exp(S) Dc Dc^* , \quad (7)$$

где S - действие (5), $Dc Dc^*$ - мера интегрирования. Следуя стандартной схеме [2], вставим в (7) интеграл по вспомогательному вещественному c - числовому полю

$$\int Dc \exp \left\{ i \sum_{\vec{p}} c_{\vec{p},6} c_{-\vec{p},6} \right\} , \quad (8)$$

где i - мнимая единица.

c - числам приписан индекс \vec{p} , поскольку в моделях, описываемых гамильтонианом (3), возможны спинзависимые решения.

В интеграле (8) произведем сдвиг

$$c_{\vec{p},6} \Rightarrow c_{\vec{p},6} - i(\beta N)^{-1/2} \sqrt{\kappa} \rho_{\vec{p},6} , \quad (9)$$

$$c_{-\vec{p},6} \Rightarrow c_{-\vec{p},6} + (\beta N)^{-1/2} \sqrt{\kappa} \rho_{-\vec{p},6} ,$$

где $\rho_{\vec{p},6}$ определяется (6).

В результате действие (5) принимает вид

$$\tilde{S} = i \sum_{\vec{p}} c_{\vec{p},6} c_{-\vec{p},6} + \sum_{\vec{k},\omega,6} (i\omega - \varepsilon_{\vec{k}}) a_{\vec{k},6}^+(\omega) a_{\vec{k},6}(\omega) + \sum_{\vec{q},\omega,6} (i\omega - \varepsilon) a_{\vec{q},6}^+(\omega) a_{\vec{q},6}(\omega) - \sqrt{\frac{2}{V}} \sum_{\omega,6, \vec{q}, \vec{k}} (V_{\vec{q},\vec{k}} a_{\vec{q},6}^+(\omega) \times \quad (10)$$

$$\times a_{\vec{k},6}(\omega) + \text{с.с.}) + i \left(\frac{\kappa}{\beta N} \right)^{1/2} \sum_{\vec{p}} (c_{\vec{p},6} \rho_{-\vec{p},6} - i c_{-\vec{p},6} \rho_{\vec{p},6}) .$$

Действие (10) квадратично по электронному грасманову ферми-полю, и по нему можно проинтегрировать в замкнутом виде. Проинтегрировав и регуляризовав определитель, получим функционал эффективного действия

$$S_{eff} = i \sum_P C_0(P) C_0(-P) + \ln \det \frac{M(c, V_{qk}^{\vec{r}}, \mu, \varepsilon)}{M(0, 0, 0, 0)} ;$$

$$M(c, V_{qk}^{\vec{r}}, \mu, \varepsilon) = \left\{ \left[(i\omega - \varepsilon_k^{\vec{r}}) \delta_{k_1 k_2}^{\vec{r}} \delta_{\omega_1 \omega_2} + (i\omega - \varepsilon) \delta_{q_1 q_2}^{\vec{r}} \delta_{\omega_1 \omega_2} \right] \right. \\ \left. - \sqrt{\frac{2}{V}} (V_{qk}^{\vec{r}} + V_{kq}^{\vec{r}}) \delta_{\omega_1 \omega_2} \right\} \left\{ (\delta_{c_1 c_2} + \delta_{-c_1 c_2}) + i \left(\frac{\mu}{\beta N} \right)^{1/2} \times \right. \\ \left. \times (C_0(P) \delta_{-c_1 c_2} \delta_{P_1 P_2} - i C_0(-P) \delta_{c_1 c_2} \delta_{P_1 P_2}) \right\} , \quad (II)$$

где δ - символ Кронекера.

Здесь регуляризация произведена таким образом, чтобы выделить изменение поверхностных свойств подложки в результате адсорбции. Следует отметить, что в определение матрицы $M(c, V_{qk}^{\vec{r}}, \mu, \varepsilon)$ входит химический потенциал, соответствующим образом перенормирующий одноэлектронный спектр системы. При этом, несмотря на то, что химические потенциалы до и после адсорбции отличаются на бесконечно малую величину, порядка отношения N/V , тем не менее эта поправка дает конечный вклад в расчет физических характеристик системы^{14/}.

Следуя работам^{12/}, представим $C_0(P)$, $C_0(-P)$ в виде

$$C_0(P) = i \sqrt{\beta N \mu} \delta_{P_0} v_0 ; \quad C_0(-P) = -\sqrt{\beta N \mu} \delta_{P_0} v_0 . \quad (I2)$$

С учетом формулы $\ln \det A = \text{Tr} \ln A$ эффективный функционал действия (II), с подставленными $C_0(P)$, $C_0(-P)$ (I2), принимает вид

$$S_{eff} = \frac{i \beta N \mu}{2} \sum_0 v_0 v_0 + \text{Tr} \ln \frac{M'(c, V_{qk}^{\vec{r}}, \mu, \varepsilon)}{M'(0, 0, 0, 0)} , \quad (I3)$$

где

$$M'(c, V_{qk}^{\vec{r}}, \mu, \varepsilon) = \left[(i\omega - \varepsilon_k^{\vec{r}}) \delta_{k_1 k_2}^{\vec{r}} + (i\omega - \varepsilon) \delta_{q_1 q_2}^{\vec{r}} \right] \times \\ \times \delta_{c_1 c_2} \delta_{\omega_1 \omega_2} - \sqrt{\frac{2}{V}} (V_{qk}^{\vec{r}} + V_{kq}^{\vec{r}}) \delta_{\omega_1 \omega_2} \delta_{c_1 c_2} , \quad \varepsilon_0 = \varepsilon + \mu v_0 .$$

А для параметров v_0 , v_0 имеем систему уравнений

$$v_{\pm 0} = \frac{1}{\beta N} \text{Tr} \left[(\delta_{\pm 0, c_1} \delta_{q_1 q_2}^{\vec{r}} \delta_{\omega_1 \omega_2} \right. \\ \left. \times \left\{ (i\omega - \varepsilon_k^{\vec{r}}) \delta_{k_1 k_2}^{\vec{r}} \delta_{\omega_1 \omega_2} \delta_{c_1 c_2} + (i\omega - \varepsilon_0) \delta_{\pm 0, c_1} \delta_{\omega_1 \omega_2} \delta_{q_1 q_2}^{\vec{r}} - \right. \right. \\ \left. \left. - \sqrt{\frac{2}{V}} (V_{qk}^{\vec{r}} + V_{kq}^{\vec{r}}) \delta_{\omega_1 \omega_2} \delta_{c_1 c_2} \right\}^{-1} \right] , \quad (I4)$$

где выбор знаков перед v_0 определен (I3). Такая система уравнений (I4) довольно сложна и может иметь как магнитное ($v_0 \neq v_0$), так и немагнитное ($v_0 = v_0$) решения. Далее сосредоточим внимание на расчете S_{eff} (I3) и его использовании для анализа свойств модельной системы.

3. РАСЧЕТ ФУНКЦИОНАЛА ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Статистические суммы неидеальной и "идеальной" $V_{qk}^{\vec{r}} - \mu = \varepsilon = 0$ систем Z , Z_0 связаны соотношением^{15/}

$$Z/Z_0 = \exp(-\beta \Omega) / \exp(-\beta \Omega_0) = \\ = \int \exp(S) \mathcal{D}a \mathcal{D}a / \int \exp(S_0) \mathcal{D}a \mathcal{D}a = \exp \sum_i \varphi_i^c , \quad (I5)$$

где $\sum_i \varphi_i^c$ - сумма вкладов связанных вакуумных диаграмм; $\Omega, \Omega_0 - \Omega$ - потенциалы идеальной и неидеальных систем. Здесь разность $(\Omega - \Omega_0)$ может быть интерпретирована как

$$(\Omega - \Omega_0) = (\alpha - \alpha_0) \Sigma , \quad (I6)$$

где α_0, α - соответствующие коэффициенты поверхностного натяжения, а Σ - площадь поверхности пленки. Образование пленки связано с "электронной" частью затрачиваемой минимальной работы (I6):

$F_{min} = (\alpha - \alpha_0) \Sigma$, а теплота адсорбции определяется формулой^{16/}

$$Q = -T^2 \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\alpha - \alpha_0}{T} \right) \right) \Sigma . \quad (I7)$$

В принятом приближении эффективного функционала действия (I3) имеем

$$R_{min} = -\beta^{-1} S_{eff}. \quad (I8)$$

Далее целесообразно функционал эффективного действия (I3) представить в виде

$$S_{eff} = \frac{\mu\beta N}{2} \sum_b \delta_b \delta_{-b} + \text{Tr} \ln \frac{M'(\theta, 0, \mu, \varepsilon)}{M'(0, 0, 0, 0)} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \text{Tr} (\hat{G} \hat{G})^{2n}, \quad (I9)$$

где $\hat{G}^{-1} = \{ (i\omega - \varepsilon_k) \delta_{k, k_1} + (i\omega - \varepsilon_b) \delta_{q, q_1} \} \delta_{\omega, \omega_1} \delta_{b, b_1}$,

$$\hat{U} = \sqrt{\frac{2}{V}} (V_{q, k}^{\rightarrow} + V_{k, q}^{\rightarrow}) \delta_{\omega, \omega_1} \delta_{b, b_1}.$$

Ограничившись квадратичными по $V_{q, k}^{\rightarrow}$ членами, для правой части формулы (I9), получим выражение

$$S_{eff} = \frac{\mu\beta N}{2} \sum_b \delta_b \delta_{-b} + \text{Tr} \ln \frac{M'(\theta, 0, \mu, \varepsilon)}{M'(0, 0, 0, 0)} - \frac{2}{V} \sum_{q, k, b, \omega} V_{q, k}^2 (i\omega - \varepsilon_k)^{-1} (i\omega - \varepsilon_b)^{-1}, \quad (20)$$

где в соответствии с вышесказанным (см. замечание после формулы (II))

$$M'(\theta, 0, \mu, \varepsilon) = (i\omega - \varepsilon_k) \delta_{k, k_1} \delta_{\omega, \omega_1} \delta_{b, b_1} + (i\omega - \varepsilon_b) \delta_{q, q_1} \delta_{b, b_1} \delta_{\omega, \omega_1};$$

$$M'(0, 0, 0, 0) = (i\omega - \varepsilon_k) \delta_{k, k_1} \delta_{\omega, \omega_1} \delta_{b, b_1} + i\omega \delta_{q, q_1} \delta_{b, b_1} \delta_{\omega, \omega_1};$$

$$\varepsilon_k^{\rightarrow} = \frac{k^2}{2m} - \mu; \quad \varepsilon_{-b} = E - \mu + \mu \delta_b; \quad \varepsilon_k^{\leftarrow} = \frac{k^2}{2m} - \mu_0.$$

μ_0 - химический потенциал электронов в чистой подложке. μ и μ_0 определяются соотношениями

$$-\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} = N_c + N = N_0, \quad -\frac{\partial \Omega}{\partial \mu_0} = N_c, \quad (21)$$

где N_c - число свободных электронов в подложке, а N_0 равно общему числу свободных электронов подложки и валентных электронов примесей. В простейшем случае $V_{q, k}^{\rightarrow} = 0$ уравнения (21) принимают вид

$$\frac{\partial}{\partial \mu} (\beta^{-1} S_{eff}) = \frac{1}{\beta} \sum_{\omega, b, q} \frac{1}{i\omega - \varepsilon_b} + \frac{1}{\beta} \sum_{\omega, k, b} \frac{1}{i\omega - \varepsilon_k^{\rightarrow}}, \quad (22)$$

$$-\frac{\partial}{\partial \mu_0} (\beta^{-1} S_{eff}) = \frac{1}{\beta} \sum_{\omega, k, b} \frac{1}{i\omega - \varepsilon_k^{\leftarrow}}.$$

Как показано ниже, сумма $\sum_{\omega, b, q} (i\omega - \varepsilon_b)^{-1}$ сводится к различным значениям, в зависимости от параметров системы ($\varepsilon, \mu, \delta_{\pm b}$). Вследствие этого может произойти изменение химического потенциала электронов подложки μ_0 .

Очевидно, что связь между химическими потенциалами можно задать в виде

$$\mu = \mu_0 + \alpha \frac{N}{V}, \quad (23)$$

где α - постоянная, зависящая от $\varepsilon, \mu, \delta_{\pm b}$.

Воспользовавшись (23), в формуле (20) отношение $\frac{M'(\theta, 0, \mu, \varepsilon)}{M'(0, 0, 0, 0)}$ представим в виде

$$\frac{M'(\theta, 0, \mu, \varepsilon)}{M'(0, 0, 0, 0)} = I + \frac{\alpha \frac{N}{V} \delta_{k, k_1} \delta_{\omega, \omega_1} \delta_{b, b_1} - (\varepsilon + \mu \delta_b) \delta_{q, q_1} \delta_{\omega, \omega_1} \delta_{b, b_1}}{M'(0, 0, 0, 0)}, \quad (24)$$

где I - единица.

С учетом представления (24), после простых преобразований, получим приближенное выражение для функционала эффективного действия

$$S_{eff} = \frac{\mu\beta N}{2} \sum_b \delta_b \delta_{-b} + \sum_{\omega, q, b} \ln \frac{i\omega - \varepsilon_b}{i\omega} + \frac{2\alpha N}{V} \sum_{k, \omega} \frac{1}{i\omega - \varepsilon_k^{\leftarrow}} - \frac{2}{V} \sum_{q, k, \omega, b} V_{q, k}^2 (i\omega - \varepsilon_k^{\rightarrow})^{-1} (i\omega - \varepsilon_b)^{-1}, \quad (25)$$

где сохранены только линейные, наиболее важные, по N/V члены. После суммирования по ферми-частоте в двух последних суммах в (25) имеем

$$S_{eff} = \frac{\mu\beta N}{2} \sum_b \delta_b \delta_{-b} + \sum_{\omega, q, b} \ln \frac{i\omega - \varepsilon_b}{i\omega} +$$

$$+ \frac{2q\beta N}{V} \sum_k \frac{1}{k} \frac{1}{e^{\beta \xi_k} + 1} - \frac{2\beta}{V} \sum_{k, q} V_{q, k}^2 (e^{\beta \xi_k} - \xi_6)^{-1} \times$$

$$\times \left\{ (e^{\beta \xi_k} + 1)^{-1} - (e^{\beta \xi_6} + 1)^{-1} \right\}. \quad (26)$$

Анализ формулы (26) показывает, что теплоемкость адсорбционной пленки, определяемая электронами, как и следовало ожидать, при малых температурах пропорциональна T .

4. УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ $\theta_{\pm 6}$ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Прежде всего определим средние числа заполнения электронов узла α со спином σ . Воспользовавшись формулой (2), имеем

$$\langle n_{\alpha, \sigma} \rangle = \frac{\sum_{q, \alpha} \frac{1}{N^2} e^{i k_{\alpha} (q - \bar{q})} \langle a_{q, \sigma}^{\dagger} a_{q, \sigma} \rangle =$$

$$= \frac{1}{N} \sum_q \langle a_{q, \sigma}^{\dagger} a_{q, \sigma} \rangle = \theta_{\sigma}. \quad (27)$$

В случае $V_{q, k}^2 = 0$ система уравнений (14) сведется к виду

$$\theta_{\pm 6} = \frac{1}{\beta} \sum_{\omega} \frac{1}{\omega (i\omega - \xi_{\pm 6})}. \quad (28)$$

После суммирования по ферми-частоте ω в (28) получим

$$\theta_{\pm 6} = \frac{1}{e^{\beta \xi_{\pm 6}} + 1}. \quad (29)$$

При $T = 0$, в зависимости от значений параметров ξ , μ (29) может иметь пять решений:

$$1. \quad \theta_{\pm 6} = 1/2, \quad \xi_{\pm 6} = 0; \quad (30)$$

$$2. \quad \theta_{+6} = 1, \quad \theta_{-6} = 0, \quad \xi_{-6} < 0; \quad \xi_6 > 0; \quad (31)$$

$$3. \quad \theta_{+6} = 0, \quad \theta_{-6} = 1, \quad \xi_{-6} > 0; \quad \xi_6 < 0. \quad (32)$$

$$4. \quad \theta_{\pm 6} = 1, \quad \xi_{\pm 6} < 0; \quad (33)$$

$$5. \quad \theta_{\pm 6} = 0, \quad \xi_{\pm 6} > 0. \quad (34)$$

В соответствии с (27) такие же результаты имеем и для $\langle n_{\alpha, \sigma} \rangle$.

В более общем случае уравнения для параметров $\theta_{\pm 6}$ следуют из разложения в ряд для матриц в (14):

$$\frac{1}{A+B} = \frac{1}{A} - \frac{1}{A} B \frac{1}{A} + \frac{1}{A} B \frac{1}{A} B \frac{1}{A} + \dots, \quad (35)$$

$$\text{где } A = (i\omega - \xi_k) \delta_{k, k'} \delta_{\omega, \omega'} \delta_{\sigma, \sigma'} + (i\omega - \xi_6) \delta_{\sigma, \sigma'} \delta_{q, q'} \delta_{\omega, \omega'},$$

$$B = - (V_{q, k}^2 + V_{k, q}^2) \sqrt{\frac{2}{V}} \delta_{\omega, \omega'} \delta_{\sigma, \sigma'}.$$

На основании формулы (35) вместо (14) будем иметь

$$\theta_{\pm 6} = \frac{1}{\beta N} \sum_{q, \omega} G_{\pm 6}(\omega) + \frac{2}{\sqrt{\beta N}} \sum_{\omega, k, q} G_{\pm 6}^2(\omega) V_{q, k}^2 + \dots, \quad (36)$$

где $G_{\pm 6} = (i\omega - \xi_{\pm 6})^{-1}$, $G_k(\omega) = (i\omega - \xi_k)^{-1}$ — функции Грина. Просуммировав ряд (36), получим систему уравнений для $\theta_{\pm 6}$

$$\theta_{\pm 6} = \frac{1}{\beta N} \sum_{\omega, q} \left\{ i\omega - \xi_{\pm 6} - \frac{2}{V} \sum_k V_{q, k}^2 (i\omega - \xi_k) \right\}^{-1}. \quad (37)$$

Чтобы получить правильный результат, сумму в (37) по ферми-частоте следует понимать как предел

$$\theta_{\pm 6} = \lim_{Z \rightarrow +0} \frac{1}{\beta N} \sum_{\omega, q} e^{i\omega Z} \left\{ i\omega - \xi_{\pm 6} - \frac{2}{V} \sum_k V_{q, k}^2 (i\omega - \xi_k) \right\}^{-1}. \quad (38)$$

Такое переопределение (37) связано с учетом порядка расстановки ферми-операторов в гамильтониане (3). Будем считать Z сколь угодно малым, но конечным. Тогда ряд (40) сходится. В случае низких температур его можно привести к виду (см., например, [17])

$$\theta_{\pm 6} = \frac{1}{2} + \frac{2}{\beta N} \sum_{q, \omega > 0} \left[(-\theta_{\pm 6} + \sum_k \frac{2|V_{q, k}|^2 \xi_k^2}{V(\omega^2 + \xi_k^2)} \right).$$

$$\left\{ \omega^2 \left(1 + \sum_{\vec{k}} \frac{2V_{\vec{q},\vec{k}}^2}{E V(\omega^2 + E_{\vec{k}}^2)} \right)^2 + \left(E_{\pm 6} - \sum_{\vec{k}} \frac{2V_{\vec{q},\vec{k}}^2 E_{\vec{k}}}{E V(\omega^2 + E_{\vec{k}}^2)} \right)^2 \right\}^{-1} =$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{N} \sum_{\vec{q}} \frac{1}{\mathcal{J}} \int_0^{\infty} d\omega \left[\left(E_{\pm 6} + \sum_{\vec{k}} \frac{2E_{\vec{k}} V_{\vec{q},\vec{k}}^2}{E V(\omega^2 + E_{\vec{k}}^2)} \right)^2 \right]^{-1} \quad (39)$$

$$\left\{ \omega^2 \left(1 + \sum_{\vec{k}} \frac{2V_{\vec{q},\vec{k}}^2}{E V(\omega^2 + E_{\vec{k}}^2)} \right)^2 + \left(E_{\pm 6} - \sum_{\vec{k}} \frac{2E_{\vec{k}} V_{\vec{q},\vec{k}}^2}{E V(\omega^2 + E_{\vec{k}}^2)} \right)^2 \right\}^{-1} \quad (39)$$

Очевидно, что при $V_{\vec{q},\vec{k}} = 0$ из (39) должны следовать решения (30)–(34). При этом будем иметь систему уравнений

$$b_{\pm 6} = -\frac{1}{\mathcal{J}} \int_0^{\infty} d\omega \frac{E_{\pm 6}}{\omega^2 + E_{\pm 6}} + \frac{1}{2}. \quad (40)$$

Из (40) следует, что в случае $E_{\pm 6} = 0$ параметры $b_{\pm 6} = 1/2$, т.е. мы имеем решение (30). $E_{\pm 6} \neq 0$,

$$b_{\pm 6} = -\frac{E_{\pm 6}}{\mathcal{J} |E_{\pm 6}|} \operatorname{arctg} \frac{\omega}{|E_{\pm 6}|} \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{2}, \quad (41)$$

что приводит к решениям (31)–(34).

Авторы глубоко благодарны В.Н. Попову за полезные обсуждения.

ЛИТЕРАТУРА

- Gavrilenko G.M. Physica A, v.150 (1988), p. 137–158.
- Возяков В.И., Попов В.Н.. Зап. научн. ЛОМИ, т.131 (1983), с.28–33; т. 145 (1985), с. 46–61; т.150 (1986), с. 7–16.
- Inglesfield J.E., Halland R.W. "Electrons at Surfaces", p.183 in book "The Chemical Physics of Solid Surfaces and Heterogeneous Catalysis", v.1, ed. D.A.King and D.D.Woodruff. Amsterdam, 1983.
- Gavrilenko G.M. and others. Preprint JINR E17-88-669, Dubna, 1988.
- Попов В.Н. Континуальные интегралы в квантовой теории поля и статистической физике, М., Атомиздат, 1976.
- Ландау Л.Д. Статистическая физика, М., Наука, 1964.
- А.А. Абрикосов, Л.П. Горьков, И.Е. Дзялошинский. Методы квантовой теории поля в статистической физике, М., Физматгиздат, 1962.

Рукопись поступила в издательский отдел
26 декабря 1988 года.

НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ?

Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, если они не были заказаны ранее.

Д13-84-63	Труды XI Международного симпозиума по ядерной электронике. Братислава, Чехословакия, 1983.	4 р. 50 к.
Д2-84-366	Труды 7 Международного совещания по проблемам квантовой теории поля. Алушта, 1984.	4 р. 30 к.
Д12-84-599	Труды VII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1984.	5 р. 50 к.
Д17-84-850	Труды III Международного симпозиума по избранным проблемам статистической механики. Дубна, 1984. (2 тома)	7 р. 75 к.
Д11-85-791	Труды Международного совещания по аналитическим вычислениям на ЭВМ и их применению в теоретической физике. Дубна, 1985.	4 р. 00 к.
Д13-85-793	Труды XII Международного симпозиума по ядерной электронике. Дубна, 1985.	4 р. 80 к.
Д4-85-851	Труды Международной школы по структуре ядра. Алушта, 1985.	3 р. 75 к.
Д3,4,17-86-747	Труды V Международной школы по нейтронной физике Алушта, 1986.	4 р. 50 к.
—	Труды IX Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1984. (2 тома)	13 р. 50 к.
Д1,2-86-668	Труды VIII Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома)	7 р. 35 к.
Д9-87-105	Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома)	13 р. 45 к.
Д7-87-68	Труды Международной школы-семинара по физике тяжелых ионов. Дубна, 1986.	7 р. 10 к.
Д2-87-123	Труды Совещания "Ренормгруппа - 86". Дубна, 1986.	4 р. 45 к.
Д4-87-692	Труды Международного совещания по теории малочастичных и кварк-адронных систем. Дубна, 1987.	4 р. 30 к.
Д2-87-798	Труды VIII Международного совещания по проблемам квантовой теории поля. Алушта, 1987.	3 р. 55 к.
Д14-87-799	Труды II Международного симпозиума по проблемам взаимодействия мюонов и пионов с веществом. Дубна, 1987.	4 р. 20 к.
Д17-88-95	Труды IV Международного симпозиума по избранным проблемам статистической механики. Дубна, 1987.	5 р. 20 к.

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79. Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.